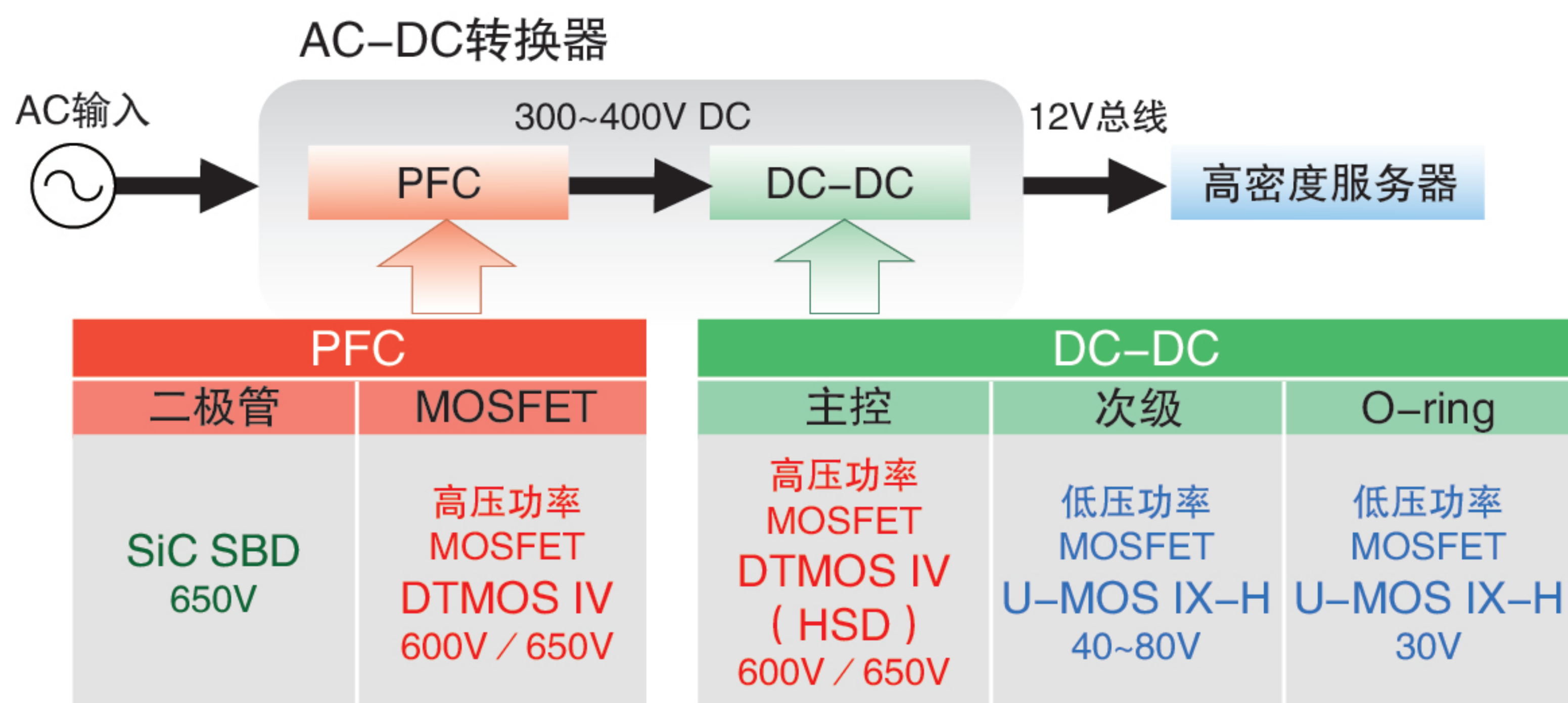


# 用于开关电源的功率MOSFET & SiC SBD

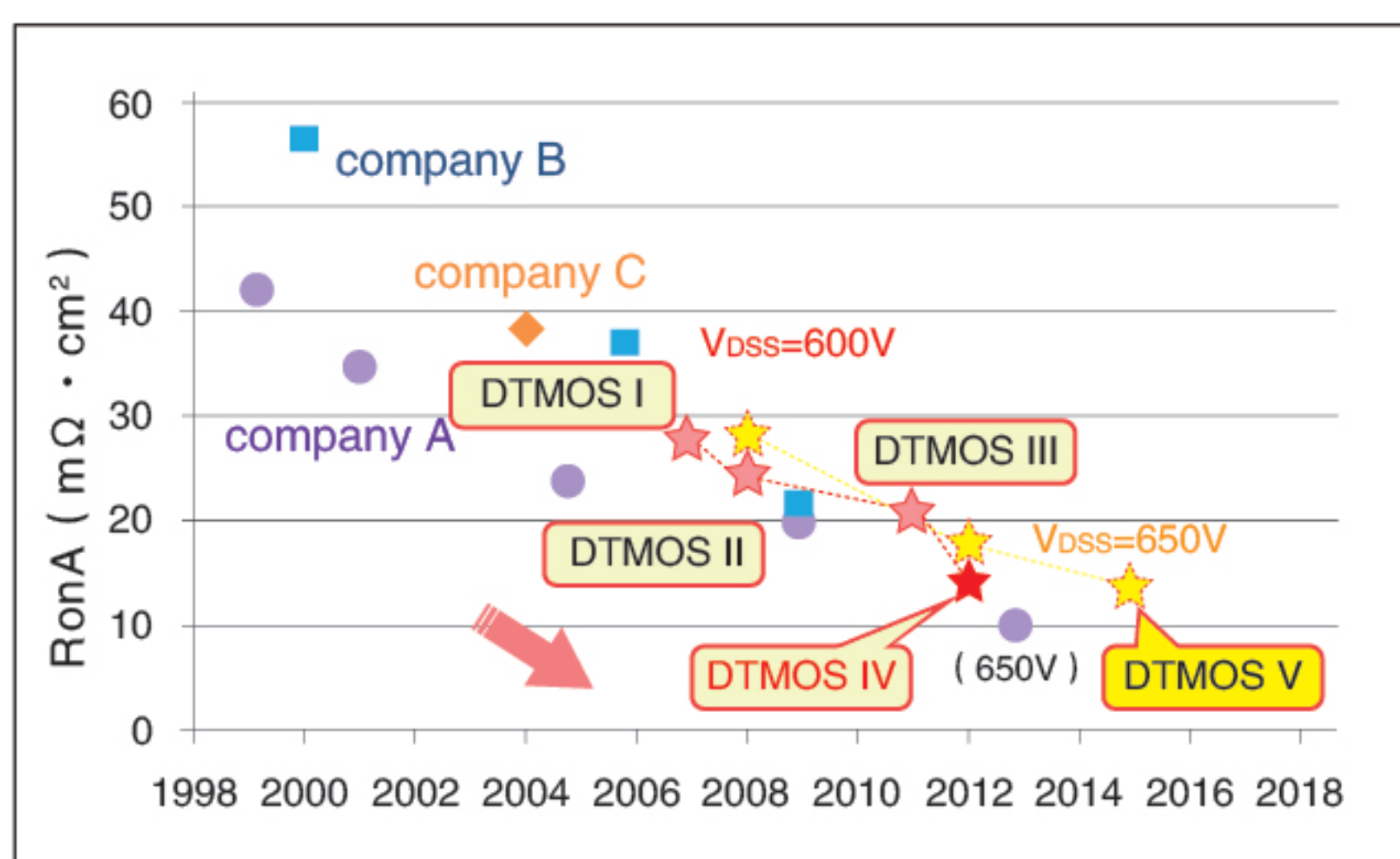
采用东芝最新工艺技术的功率器件，可提高开关电源的效率

开关电源系统的结构及建议（适用于服务器）



## DTMOSIV ( $V_{DSS}=600\sim650V$ )

- > 因采用单层外延技术而具有最佳的  $R_{on}\cdot A$  和更好的温度系数
- > 因较小的  $C_{oss}$  而具有更好的轻负载效率
- > 带快恢二极管的系列产品



## U-MOSIX-H ( $V_{DSS}=30\sim100V$ )

TPHR8504PL ( Nch 40V )

已量产

- > 最佳的  $R_{DS(ON)}$  :  
0.7mΩ 典型值 @  $V_{GS}=10V$
- > 低的  $Q_{oss}\cdot R_{on}$  特征:  
60nC·mΩ @  $V_{DS}=20V$

